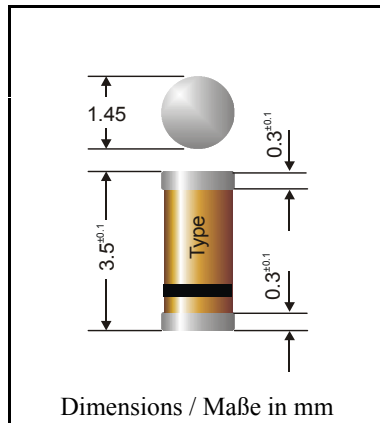


Surface Mount Si-Schottky Barrier Diodes**Silizium-Schottky-Dioden
für die Oberflächenmontage**

Nominal current Nennstrom	0.2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...40 V
Glass case MiniMELF Glasgehäuse MiniMELF	SOD 80 DO-213AA
Weight approx.– Gewicht ca.	0.05 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings and Characteristics**Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Forward voltage Durchlaßspannung V_F [V] / $I_F = 20$ mA	V_F [V] / $I_F = 200$ mA
LL 103C	20	< 0.37	< 0.6
LL 103B	30	< 0.37	< 0.6
LL 103A	40	< 0.37	< 0.6

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	400 mW ¹⁾
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	15 A
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R < 5 \mu\text{A}$
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 0$ V	$f = 1$ MHz	C_{tot} typ. 50 pF
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 200$ mA through/über $I_R = 200$ mA to/auf $I_R = 20$ mA	t_{rr}	typ. 10 ns
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	+125°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 55...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 300 K/W ¹⁾

¹⁾ Valid provided that terminals are kept at ambient temperature
Gültig wenn Anschlüsse auf Umgebungstemperatur gehalten werden